

電気学会研究会資料目次

電子材料研究会

〔委員長〕羽路伸夫（横浜国立大学）

〔幹事〕岡田至崇（筑波大学），西川宏之（芝浦工業大学）

日時 平成19年11月30日（金）13:00～16:40

場所 福井大学 工学部 文京キャンパス アカデミーホール（福井市文京3-9-1 JR福井駅前（10のりば）福井大学前下車（所要時間 約10分），私鉄えちぜん鉄道，福井駅ー福大前西福井駅下車（所要時間 約10分 http://www.fukui-u.ac.jp/publication/site/idx_access.html）

テーマ「ワイドギャップ半導体材料，デバイス一般」

- EFM-07-15 p-GaN ショットキー接触の I-V, C-V 特性- 金属仕事関数依存性-
福島慶広，荻須啓太，葛原正明，塩島謙次（福井大学）…………… 1
- EFM-07-16 金属／ダイヤモンド界面と深紫外線センサ素子
小出康夫，廖 梅勇（物質・材料研究機構）…………… 5
ホセアルバレット（フランス国立科学研究センター）
- EFM-07-17 多重台形チャネルを持つ AlGaIn/GaN HEMT の特性
田村隆博，橋詰 保，小谷淳二，葛西誠也（北海道大学）…………… 11
- EFM-07-18 導電性基板上 GaN HEMT の縦方向電界による電流コラプス現象
吉岡 啓，新田智洋，藤本英俊，野田隆夫，齋藤泰伸（東芝）…………… 15
- EFM-07-19 FP 構造を有する高耐圧 GaN-HEMT の電流コラプスとゲートチャージ
齋藤 渉，新田智洋，垣内頼人，齋藤泰伸…………… 21
津田邦男，大村一郎，山口正一（東芝）
- EFM-07-20 高利得高効率電力増幅器用 GaN-HEMT 技術
星 真一，大来英之，森野芳昭，伊藤正紀，関 昇平（沖電気工業）…………… 25

EFM-07-21 縦型 GaN パワーデバイスの開発

兼近将一（豊田中央研究所）…………… 31

杉本雅裕（トヨタ自動車）

副島成雅，上田博之，石黒 修，樹神雅人，林 栄子

伊藤健治，上杉 勉，加地 徹（豊田中央研究所）

EFM-07-22 GaN 系 MOSFET のアンペアクラス 250°C動作

新山勇樹，神林 宏，大友晋哉，野村剛彦，吉田清輝（古河電気工業）…………… 35

協 賛 次世代ハイパワー応用ワイドギャップ半導体材料技術調査専門委員会